

BACK-END

IGBT

BIAS TESTER バイアステスター

BNI5000RQ 5.0KV



- BNI5000RQ is a bias tester applying power to semiconductor devices for extended period of time in a high-temperature environment to check the degradation performance status. The 12 device storage spaces enable heat-up to 200°C and power application for up to 999 hours.
- BNI5000RQ は半導体デバイスに高温環境で長時間電力を印加し、劣化性能を状況を確認するバイアステスターです。12 のデバイス収納スペースは 200°C までのヒートアップが可能であり、999 時間までの電力印加を可能としています。

MODEL	BNI5000RQ
測定仕様	
印加条件	VGS: ±30V VDS: 最大5.0kV (出力電流: 60mA、1台2素子共通全12台搭載)
測定項目	設定データ取得間隔にて12素子同時測定 ICE: 99.99 μA/999.9 μA/99.99mA (3レンジ) IGES: 99.99nA/999.9nA/9.999 μA (3レンジ) VCE: 5.000kV (1レンジ)
印加時間	最大: 999h
データ取得間隔	1秒~60秒 ※WindowsPCの時刻関数にてデータを取得する。
ヒーターステージサイズ	250(W)×160(D)
ヒーター設定温度	常温~200°C (ヒーター中心部温度精度+3°C、-1°C以内)
DIMENSIONS & WEIGHT	
MAIN UNIT	2200(W)×1750(D)×1000(H)・・・1200kg